(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年2 月26 日 (26.02.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/017392 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/268

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/010223

(22) 国際出願日: 2003 年8 月11 日 (11.08.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-236054 2002 年8 月13 日 (13.08.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 東芝 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) [JP/JP]; 〒105-8001 東京都 港区 芝浦一丁目１番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 三橋 浩 (MITSUHASHI,Hiroshi) [JP/JP]; 〒105-8001 東京都 港区 芝浦一丁目１番１号 株式会社 東芝 知的財産部内 Tokyo (JP). 溝内 清継 (MIZOUCHI,Kiyotsugu) [JP/JP]; 〒105-8001 東京都 港区 芝浦一丁目１番１号 株式会社 東芝 知的財産部内 Tokyo (JP). 粟野 孝司 (AWANO,Takashi) [JP/JP]; 〒105-8001 東京都 港区 芝浦一丁目１番１号 株式会社 東芝 知的財産部内 Tokyo (JP).

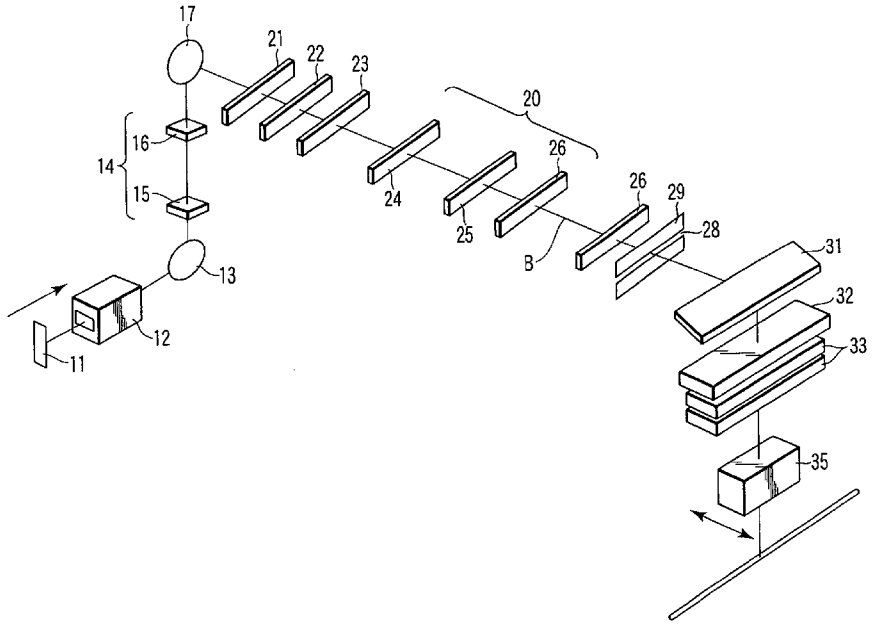
(74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE,Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都 千代田区 霞が関３丁目７番２号 鈴榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): JP, KR, SG, US.

[続葉有]

(54) Title: LASER APPLICATION METHOD

(54) 発明の名称: レーザ照射方法



(57) Abstract: A laser application method in which a linear laser beam is reflected from a mirror to bend the optical path of the laser beam, the width of the laser beam in the minor axis direction is adjusted by a minor-axis homogenizer, and the laser beam is applied to an amorphous silicon semiconductor on a light-transmitting substrate. The intensity of the laser beam is adjusted by adjusting the angle of the mirror.

(57) 要約: 線状のレーザビームをミラーにより反射させて、レーザビームの光路を屈曲させ、前記ミラーにより光路が屈曲されたレーザビームの短軸方向の幅を短軸ホモジナイザにより調整し、

[続葉有]

WO 2004/017392 A1

添付公開書類:
— 国際調査報告書
— 補正書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

前記短軸ホモジナイザにより短軸方向の幅が調整された前記レーザビームを透光性基板上の非晶質シリコン半導体に照射するレーザ照射方法であって、前記ミラーの角度を調整して前記レーザビームの強さを調整するレーザ照射方法。